MMBTA13 / MMBTA14

NPN SURFACE MOUNT DARLINGTON TRANSISTOR

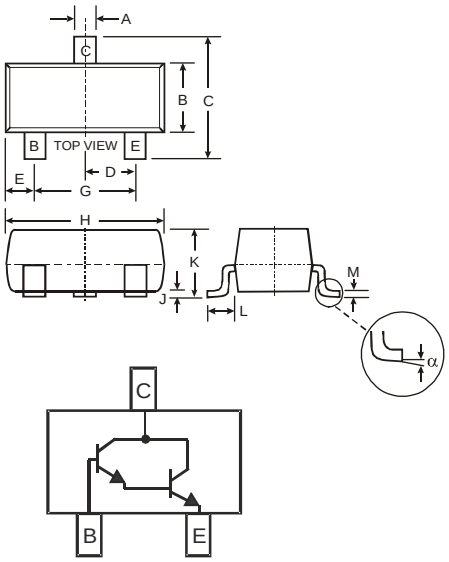
Please click here to visit our online spice models database.

Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary PNP Types Available (MMBTA63 /MMBTA64)
- Ideal for Medium Power Amplification and Switching
- High Current Gain
- **Lead, Halogen and Antimony Free, RoHS Compliant "Green" Device (Notes 3 and 4)**
- **Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability**

Mechanical Data

- Case: SOT-23
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminal Connections: See Diagram
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Lead Free Plating (Matte Tin Finish annealed over Alloy 42 leadframe).
- MMBTA13 Marking (See Page 3): K2D, K3D
- MMBTA14 Marking (See Page 3): K3D
- Ordering & Date Code Information: See Page 3
- Weight: 0.008 grams (approximate)



SOT-23		
Dim	**Min**	**Max**
A	0.37	0.51
B	1.20	1.40
C	2.30	2.50
D	0.89	1.03
E	0.45	0.60
G	1.78	2.05
H	2.80	3.00
J	0.013	0.10
K	0.903	1.10
L	0.45	0.61
M	0.085	0.180
α	0°	8°
All Dimensions in mm		

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	30	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	10	V
Collector Current - Continuous	I_C	300	mA
Power Dissipation (Note 1)	P_D	300	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1)	$R_{\theta JA}$	417	°CW
Operating and Storage and Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	°C

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic		Symbol	Min	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 2)						
Collector-Emitter Breakdown Voltage		$V_{(BR)CEO}$	30	—	V	I_C = 100μA V_{BE} = 0V
Collector Cutoff Current		I_{CBO}	—	100	nA	V_{CB} = 30V, I_E = 0
Emitter Cutoff Current		I_{EBO}	—	100	nA	V_{EB} = 10V, I_C = 0
ON CHARACTERISTICS (Note 2)						
DC Current Gain	MMBTA13	h_{FE}	5,000	—	—	I_C = 10mA, V_{CE} = 5.0V
	MMBTA14		10,000			I_C = 10mA, V_{CE} = 5.0V
	MMBTA13		10,000			I_C = 100mA, V_{CE} = 5.0V
	MMBTA14		20,000			I_C = 100mA, V_{CE} = 5.0V
Collector-Emitter Saturation Voltage		$V_{CE(SAT)}$	—	1.5	V	I_C = 100mA, I_B = 100μA
Base-Emitter Saturation Voltage		$V_{BE(SAT)}$	—	2.0	V	I_C = 100mA, V_{CE} = 5.0V
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS						
Output Capacitance		C_{obo}	8.0 Typical		pF	V_{CB} = 10V, f = 1.0MHz, I_E = 0
Input Capacitance		C_{ibo}	15 Typical		pF	V_{EB} = 0.5V, f = 1.0MHz, I_C = 0
Current Gain-Bandwidth Product		f_T	125	—	MHz	V_{CE} = 5.0V, I_C = 10mA, f = 100MHz

Notes:
1. Device mounted on FR-4 PCB, 1 inch x 0.85 inch x 0.062 inch; pad layout as shown on Diodes Inc. suggested pad layout document AP02001, which can be found on our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf.
2. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
3. No purposefully added lead. Halogen and Antimony Free.
4. Product manufactured with Data Code V9 (week 33, 2008) and newer are built with Green Molding Compound. Product manufactured prior to Date Code V9 are built with Non-Green Molding Compound and may contain Halogens or Sb_2O_3 Fire Retardants.

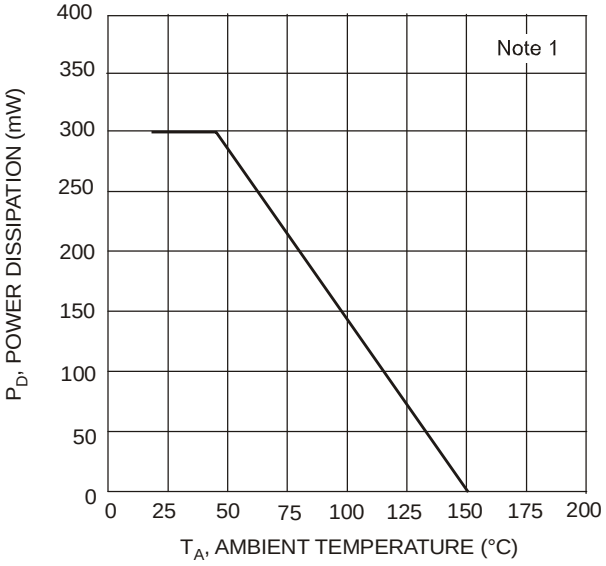


Fig. 1, Max Power Dissipation vs Ambient Temperature

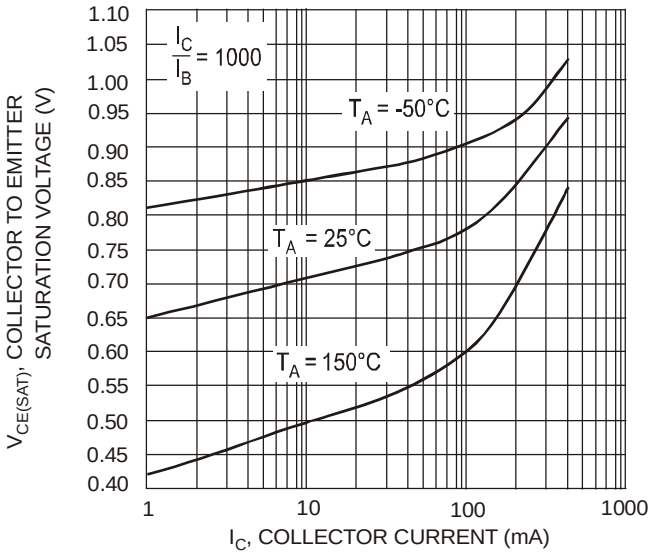


Fig. 2, Collector Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

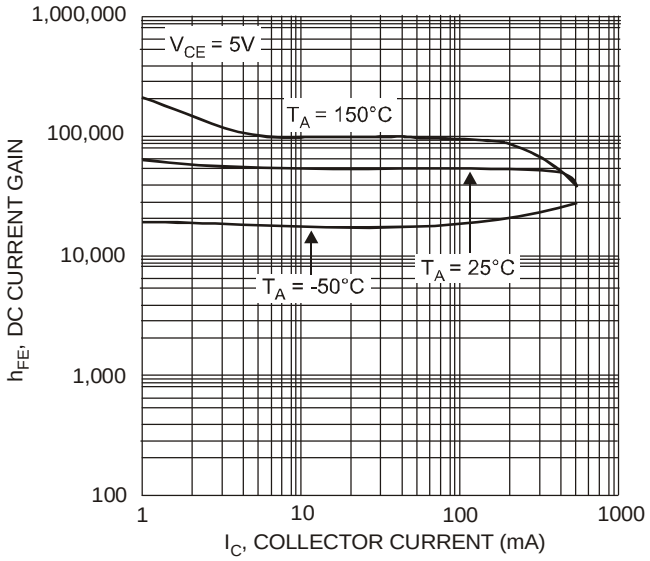


Fig. 3, DC Current Gain vs Collector Current

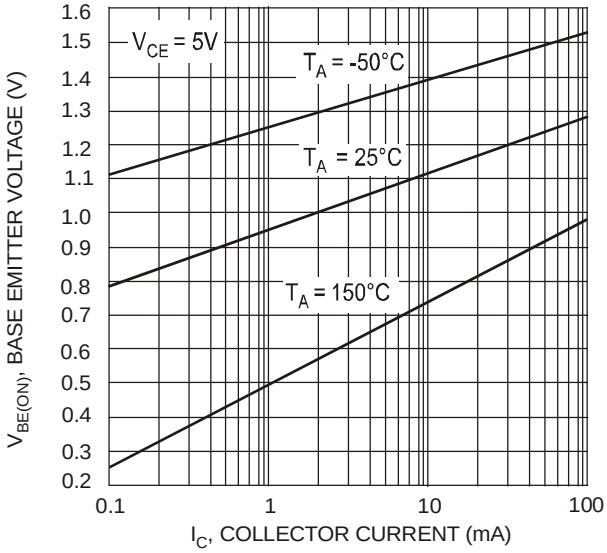


Fig. 4, Base Emitter Voltage vs. Collector Current

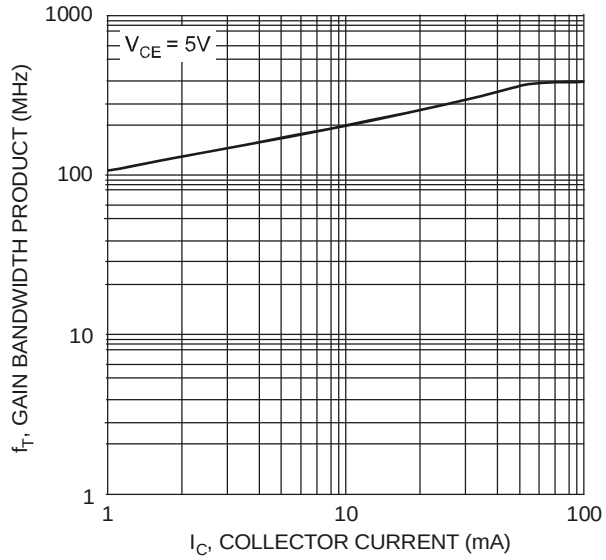


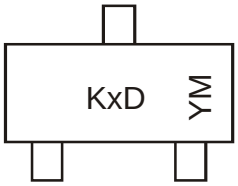
Fig. 5, Gain Bandwidth Product vs Collector Current

Ordering Information (Note 5)

Device	Packaging	Shipping
MMBTA13-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel
MMBTA14-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel

Notes: 5. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf.

Marking Information



KxD = Product Type Marking Code, ex: K2D = MMBTA13
YM = Date Code Marking
Y = Year ex: N = 2002
M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9